

HGLD-650T05.6-ZP-10mW

产品规格说明书



■ 应用范围

测距、光源指示、条码阅读、传感器。

■ 主要特点

有源区应变量子阱结构、高效率、高可靠性。

■ 封装形式

T05.6 标准管壳封装。

■ 参数极值

参数	符号	极值	单位
最大出光功率	P_o	12	mW
最大 LD 反向电压	V_{Rld}	2	V
最大 PD 反向电压	V_{Rpd}	30	V
工作温度	T_{op}	-40 ~ 60	°C
存储温度	T_{stg}	-40 ~ 80	°C

■ 光电参数（25°C下测量）

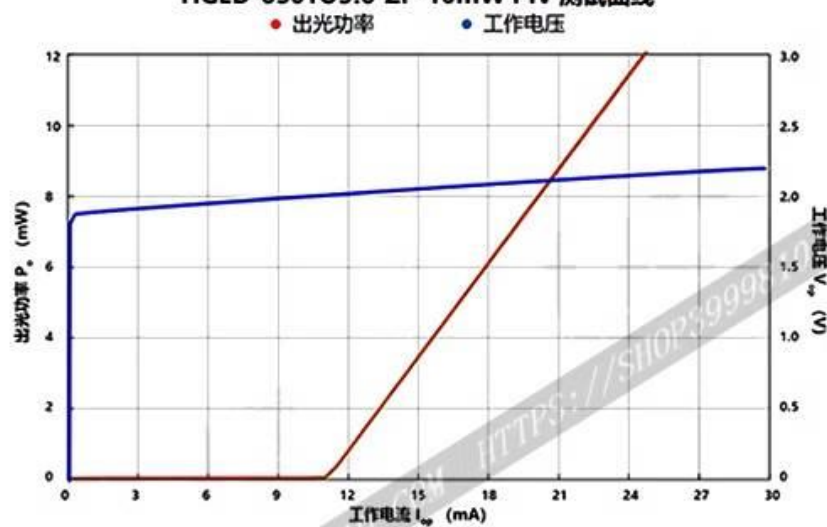
参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
额定出光功率	P_o	-	10	-	mW
中心波长	λ	-	650	660	nm
阈值电流	I_{th}	-	11	15	mA
工作电流	I_{op}	-	22	25	mA
工作电压	V_{op}	-	2.1	2.3	V
斜率效率	SE	0.6	0.9	-	W/A
监控电流	I_m	-	0.2	0.3	mA
发散角	$\theta_{\perp} \times \theta_{\parallel}$		38°×8°	42°×10°	Deg

注 1：上表均为额定出光功率 10mW 下光电参数；

注 2：发散角 $\theta_{\perp}$ 及 $\theta_{\parallel}$ 均为半峰宽（FWHM）。

■ 典型 PIV 测试曲线

HGLD-650T05.6-ZP-10mW PIV 测试曲线



■ 外形尺寸 (单位: mm)

